

## NPN HIGH POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/371

### Devices

**2N3902**

**2N5157**

### Qualified Level

**JAN  
JANTX**

### MAXIMUM RATINGS

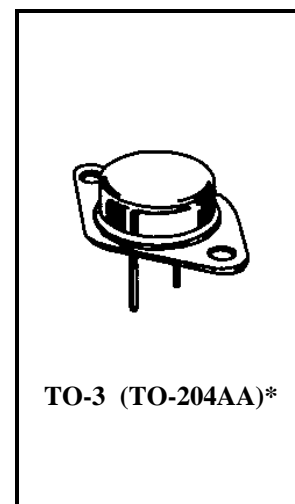
Ratings	Symbol	2N3902	2N5157	Unit
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	400	500	Vdc
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5.0	6.0	Vdc
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	700		Vdc
Base Current	$I_B$	2.0		Adc
Collector Current	$I_C$	3.5		Adc
Total Power Dissipation	$P_T$	@ $T_A = +25^{\circ}C$ <sup>(1)</sup>	5.0	W
		@ $T_C = +75^{\circ}C$ <sup>(2)</sup>	100	W
Operating & Storage Temperature Range	$T_j, T_{stg}$	-65 to +200		$^{\circ}C$

### THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	1.25	$^{\circ}C/W$

1) Derate linearly 29 mW/ $^{\circ}C$  for  $T_A > +25^{\circ}C$

2) Derate linearly 0.8 mW/ $^{\circ}C$  for  $T_C > +75^{\circ}C$



\*See Appendix A for Package Outline

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

### OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 325$ Vdc $V_{CE} = 400$ Vdc	2N3902 2N5157	$I_{CEO}$	250 250	$\mu A_{dc}$
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{BE} = 1.5$ Vdc; $V_{CE} = 700$ Vdc		$I_{CEX}$	500	$\mu A_{dc}$
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 5.0$ Vdc $V_{EB} = 6.0$ Vdc	2N3902 2N5157	$I_{EBO}$	200 200	$\mu A_{dc}$

### ON CHARACTERISTICS<sup>(3)</sup>

Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 1.0$ Adc; $I_B = 0.1$ Adc $I_C = 3.5$ Adc; $I_B = 0.7$ Adc		$V_{BE(sat)}$	1.5 2.0	Vdc
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 1.0$ Adc; $I_B = 0.1$ Adc $I_C = 3.5$ Adc; $I_B = 0.7$ Adc		$V_{CE(sat)}$	0.8 2.5	Vdc

**2N3902, 2N5157 JAN SERIES**

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)**

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
<b>ON CHARACTERISTICS<sup>(3)</sup> (con't)</b>				
Forward-Current Transfer Ratio I <sub>C</sub> = 0.5 Adc; V <sub>CE</sub> = 5.0 Vdc I <sub>C</sub> = 1.0 Adc; V <sub>CE</sub> = 5.0 Vdc I <sub>C</sub> = 2.5 Adc; V <sub>CE</sub> = 5.0 Vdc I <sub>C</sub> = 3.5 Adc; V <sub>CE</sub> = 5.0 Vdc	h <sub>FE</sub>	25 30 10 5	90	
Collector-Emitter Sustaining Voltage I <sub>C</sub> = 100 mAdc	V <sub>CEO(sus)</sub>	2N3902 2N5157	325 400	Vdc

**DYNAMIC CHARACTERISTICS**

Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I <sub>C</sub> = 0.2 Adc; V <sub>CE</sub> = 10 Vdc, f = 1 MHz	h <sub>fe</sub>	2.5	25	
Output Capacitance V <sub>CB</sub> = 10 Vdc; I <sub>E</sub> = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C <sub>obo</sub>		250	pF

**SWITCHING CHARACTERISTICS**

Turn-On Time V <sub>CC</sub> = 125 Vdc; I <sub>C</sub> = 1.0 Adc; I <sub>B1</sub> = 0.1 Adc	t <sub>on</sub>		0.8	μs
Turn-Off Time V <sub>CC</sub> = 125 Vdc; I <sub>C</sub> = 1.0 Adc; I <sub>B1</sub> = 0.1 Adc; -I <sub>B2</sub> = 0.50 Adc	t <sub>off</sub>		1.7	μs

**SAFE OPERATING AREA**

**DC Tests (continuous)**

T<sub>C</sub> = +25°C; t ≥ 1.0 s (See Figure 3 of MIL-PRF-19500/371)

**Test 1**

V<sub>CE</sub> = 28.6 Vdc, I<sub>C</sub> = 3.5 Adc

**Test 2**

V<sub>CE</sub> = 70 Vdc, I<sub>C</sub> = 1.43 Adc

**Test 3**

V<sub>CE</sub> = 325 Vdc, I<sub>C</sub> = 55 mAdc                      2N3902

V<sub>CE</sub> = 400 Vdc, I<sub>C</sub> = 35 mAdc                      2N5157

**Switching Tests**

**Load condition C (unclamped inductive load)**

T<sub>C</sub> = 25°C; duty cycle ≤ 10%; R<sub>S</sub> = 0.1 Ω (See Figure 4 of MIL-PRF-19500/371)

**Test 1**

t<sub>P</sub> = approximately 3 ms (vary to obtain I<sub>C</sub>); R<sub>BB1</sub> = 20 Ω; V<sub>BB1</sub> = 10 Vdc; R<sub>BB2</sub> = 3 kΩ;  
V<sub>BB2</sub> = 1.5 Vdc; V<sub>CC</sub> = 50 Vdc; I<sub>C</sub> = 3.5 Adc; L = 60 mH; R = 3 Ω; R<sub>L</sub> ≤ 14Ω.

**Test 2**

t<sub>P</sub> = approximately 3 ms (vary to obtain I<sub>C</sub>); R<sub>BB1</sub> = 100 Ω; V<sub>BB1</sub> = 10 Vdc; R<sub>BB2</sub> = 3 kΩ;  
V<sub>BB2</sub> = 1.5 Vdc; I<sub>C</sub> = 0.6 Adc V<sub>CC</sub> = 50 Vdc; L = 200 mH; R = 8 Ω; R<sub>L</sub> ≤ 83Ω.

**Switching Tests**

**Load condition (clamped inductive load)**

T<sub>C</sub> = +25°C; duty cycle ≤ 10%. (See Figure 5 of MIL-PRF-19500/371)

**Test 1**

t<sub>P</sub> = approximately 30 ms (vary to obtain I<sub>C</sub>); R<sub>S</sub> = 0.1 Ω; R<sub>BB1</sub> = 20 Ω; V<sub>BB1</sub> = 10 Vdc; R<sub>BB2</sub> = 100 Ω;  
V<sub>BB2</sub> = 1.5 Vdc; V<sub>CC</sub> = 50 Vdc; I<sub>C</sub> = 3.5 Adc; L = 60 mH; R = 3 Ω; R<sub>L</sub> ≥ 0Ω.

(A suitable clamping circuit or diode can be used.)

Clamp Voltage = 400 +0, -5 Vdc                      2N3902

Clamp Voltage = 500 +0, -5 Vdc                      2N5157

(Clamped voltage must be reached)

3.) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331